(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

PCT

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
5. Juli 2007 (05.07.2007)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2007/073886 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
B05C 1/02 (2006.01) *H05K 3/00* (2006.01)
B05C 1/08 (2006.01) *B05C 1/16* (2006.01)
B05C 1/10 (2006.01) *B05C 13/02* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2006/012116

(22) Internationales Anmeldedatum:
15. Dezember 2006 (15.12.2006)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2005 062 528.2
16. Dezember 2005 (16.12.2005) DE

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: **GEBR. SCHMID GMBH + CO.** [DE/DE]; Robert-Bosch-Strasse 32-34, 72250 Freudenstadt (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: **KAPPLER, Heinz** [DE/DE]; Bergwiese 11, 72280 Dornstetten-Aach (DE).

(74) Anwalt: **RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER & PARTNER**; Kronenstrasse 30, 70174 Stuttgart (DE).

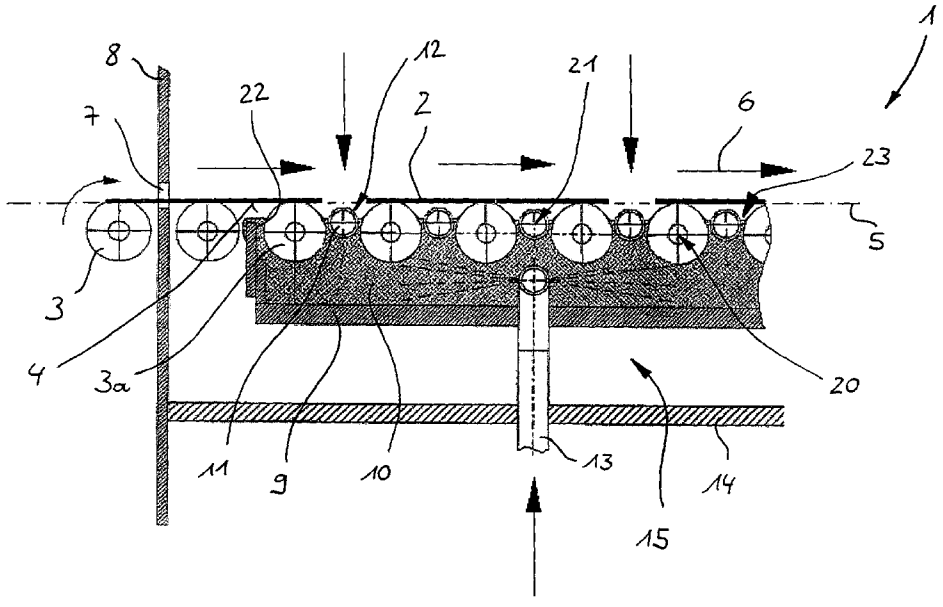
(81) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart)*: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) **Title:** DEVICE, SYSTEM AND METHOD FOR TREATING THE SURFACES OF SUBSTRATES

(54) **Bezeichnung:** VORRICHTUNG, ANLAGE UND VERFAHREN ZUR OBERFLÄCHENBEHANDLUNG VON SUBSTRATEN



(57) **Abstract:** The invention relates to a device (1, 1') for treating the surfaces of silicon wafers (2), comprising transport rollers (3) for transporting the silicon wafers (2) on a transport plane (5) which is determined by the transport rollers (3), and at least one conveyor device (3a) which wets the silicon wafer (2) with an aqueous process medium (10). The conveyor device (3a) is arranged in such a manner below the transport plane (5) that it touches the transport plane for wetting the substrate surface, which is oriented in the downward direction, with a process medium (10). Said conveyor device is in direct contact with the substrate surface.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2007/073886 A1

Veröffentlicht:
— *mit internationalem Recherchenbericht*
— *vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen*

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung (1, 1') zur Oberflächenbehandlung von Silizium-Wafern (2) weist Transportwalzen (3) zum Transport der Silizium-Wafer (2) in einer von den Transportwalzen (3) bestimmten Transportebene (5) und zumindest eine Fördereinrichtung (3a) auf, die für eine Benetzung des Silizium-Wafers (2) mit einem flüssigen Prozessmedium (10) ausgebildet ist. Die Fördereinrichtung (3a) ist derart unterhalb der Transportebene (5) angeordnet, dass sie die Transportebene berührt zur Benetzung der nach unten gerichteten Substratoberfläche mit Prozessmedium (10) in direktem Kontakt zwischen Fördereinrichtung und Substratoberfläche.